# ハイブリッド接合技術開発・事業成果概要

#### 実施者

東レエンジニアリング株式会社

### 事業概要

AIサーバーやデータセンターなどに用いられる半導体パッケージのさらなる高性能化のためにヘテロジニアス構造(チップレット)を実現するD2Wハイブリッド接合用ボンダーの開発をする。



ハイエンド半導体パッケージ の高性能化に必須であるハ イブリッド接合技術を確立し た。

装置開発は、東レエンジニアリング、TEGの設計製作、接合評価、分析を東北大学、横浜国立大学、筑波大学が実施した。

## 社会実装イメージ

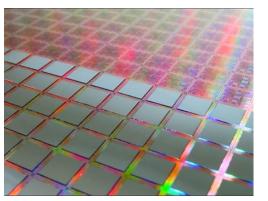


ハイブリッド接合用ボンダー(UC5000)

ハイブリッド接合を用いた半導体パッケージのチップレット化および高性能化が進み、生成AIなどの活用による日常生活の利便性向上に寄与する。

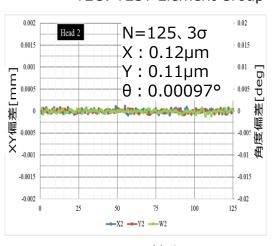
### 事業成果

ハイブリッド接合用に必要である0.2µm 以下の超高精度アライメント技術かつ 2200UPHの高生産性を両立した UC5000を開発した。本装置では、ISO クラス3の高クリーン度、活性化された接 合面の非接触搬送技術も搭載している。 接合評価のために、世界最小レベルの 電極サイズ1.5umを設計製作し、電気 特性や信頼性試験を実施することで接 合評価手法を示した。また、接合メカニ ズム、活性化条件、活性化後の経過時 間などの関係性を分析し、ハイブリッド接 合に必要な前工程条件を見いだすことが できた。

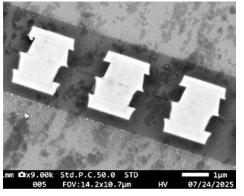


TEG外観

D2W: Die to Wafer TEG: TEST Element Group



アライメント精度



接合界面(電極サイズ1.5µm)